



Toshiba bringt N-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit 60 V und 100 V in drei neuen Gehäuseoptionen auf den Markt, um die Effizienz von Stromleitungen in Industrieanlagen zu verbessern

Um der steigenden Nachfrage nach 48-V- und 24-V-Stromversorgungssystemen gerecht zu werden, nutzt die neue Produktserie vielseitige SOT-23F-, wärmeableitende TSOP6F- und platzsparende UDFN6B-Gehäuse

Düsseldorf, Deutschland, 18. Juni 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH („Toshiba“) hat ihr Portfolio an N-Kanal-Leistungs-MOSFETs um neun neue Bausteine in drei verschiedenen kompakten, wärmeableitenden Gehäusen erweitert. Die neue Produktserie umfasst drei 100-V-MOSFETs für 48-V-Stromleitungen in Industrieanlagen sowie sechs 60-V-MOSFETs für 24-V-Systeme.

Diese neuen Produkte sind eine direkte Reaktion auf aktuelle Markttrends: In Industrieanlagen verlagert sich die Stromversorgung immer mehr von herkömmlichen 12-V- und 24-V-Systemen zu 48-V-Systemen, um den Stromverbrauch zu senken. Da es in 48-V-Leitungen durch Einschaltströme und Überspannungen zu Spannungen von über 50 V bis 80 V kommen kann, werden für einen zuverlässigen Betrieb MOSFETs mit einer Nennspannung von 100 V benötigt. Mit steigenden Versorgungsspannungen gehen zusätzlich ein höherer Wirkungsgrad, geringere Verluste und kleinere Abmessungen einher. Als Reaktion auf diese Markttrends hat Toshiba MOSFETs für 48-V- sowie für die derzeit gängigen 24-V-Leitungen entwickelt.

Um den unterschiedlichen Anforderungen moderner Industrieanlagen gerecht zu werden, sind die MOSFETs in drei verschiedenen Gehäusetypen erhältlich. Für Entwickler, die Wert auf Vielseitigkeit und einfache Implementierung legen, ist das SOT-23F-Gehäuse mit den Abmessungen 2,9 x 2,4 mm und einer Verlustleistung von 1 W eine ausgezeichnete Wahl. Bei Anwendungen, für die eine höhere Verlustleistung und eine hervorragende Wärmeableitung benötigt werden, steht das TSOP6F-Gehäuse mit einer Verlustleistung von 1,5 W und den Maßen 2,9 x 2,8 mm zur Verfügung. Bei Designs, bei

denen es auf Miniaturisierung ankommt, bietet das UDFN6B-Gehäuse mit einer typischen Grundfläche von nur 2,0 x 2,0 mm und einer Nenn-Verlustleistung von 1,25 W eine extrem kompakte, platzsparende Lösung.

Trotz ihrer kompakten Abmessungen weisen alle drei Gehäusetypen einen niedrigen Einschaltwiderstand ($R_{DS(ON)}$) auf. Dadurch wird der Stromverbrauch der Anlagen erheblich reduziert. Die Kombination aus hoher Effizienz, geringen Verlusten und kompakten Abmessungen eröffnet eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten: von in der Industrie eingesetzten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Wechselrichtern/Servomotoren über Server bis hin zu Haushaltsgeräten wie LED-Leuchten, Warmwasserbereitern, Wasserreinigern und Roboterstaubsaugern.

Für 48-V-Stromleitungen bietet Toshiba N-Kanal-MOSFETs mit einer Nennspannung von 100 V und einem Einschaltwiderstand $R_{DS(ON)}$ von 198 m Ω an:

[SSM3K387R](#) [SOT-23F]

[SSM6K387R](#) [TSOP6F]

[SSM6K387NU](#) [UDFN6B]

Für 24-V-Stromleitungen bietet Toshiba N-Kanal-MOSFETs mit einer Nennspannung von 60 V und einem Einschaltwiderstand $R_{DS(ON)}$ von 99 m Ω an:

[SSM3K388R](#) [SOT-23F]

[SSM6K388R](#) [TSOP6F]

[SSM6K388NU](#) [UDFN6B]

Für 24-V-Stromleitungen bietet Toshiba N-Kanal-MOSFETs mit einer Nennspannung von 60 V und einem Einschaltwiderstand $R_{DS(ON)}$ von 200 m Ω an:

[SSM3K389R](#) [SOT-23F]

[SSM6K389R](#) [TSOP6F]

[SSM6K389NU](#) [UDFN6B]

Um den wachsenden Anforderungen an hocheffiziente, miniaturisierte Stromversorgungslösungen in der Industrie gerecht zu werden, erweitert Toshiba kontinuierlich sein Angebot an N-Kanal-MOSFETs.

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) bietet Verbrauchern und Unternehmen in Europa eine große Auswahl an Festplattenlaufwerken (HDDs) sowie Halbleiterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie, IoT, Bewegungssteuerung, Telekommunikation, Netzwerke, Consumer und Haushaltsgeräte. Neben HDDs umfasst das Angebot auch Leistungshalbleiter und andere diskrete Bauelemente von Dioden bis hin zu Logik-ICs, Optoelektronik sowie Mikrocontrollern/MCUs und anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). Darüber hinaus bietet TEE auch SCiB™-Batteriezellen und -Module mit Lithium-Titan-Oxid (LTO) für Hochleistungsanwendungen.

TEE hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien, die Marketing-, Vertriebs- und Logistikdienstleistungen anbieten.

Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden sich auf den Websites von Toshiba unter www.toshiba.semicon-storage.com und www.scib.jp/en.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 (0) 211 5296 0
Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH
Tel: +44 (0)7464 493526
E-Mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Pretzl Group Ltd.
Tel: +49 (0)172 617 8431
Web: www.pretzl.com
E-Mail: birgit.schoeniger@pretzl.com

Juni 2026

Ref. 7669(A)G